課題番号 GR088

先端研究助成基金助成金(最先端・次世代研究開発支援プログラム) 実施状況報告書(平成 24 年度)

本様式の内容は一般に公表されます

研究課題名	超高性能インクジェットプリンテッドエレクトロニクス
研究機関· 部局·職名	早稲田大学・先進理工学部・教授
氏名	竹延 大志

1. 当該年度の研究目的

平成24年度は、以下の3項目における研究目的に沿って研究を推進した。

(1)以 法に関する基盤技術確立

これまでに確立した SWCNT 薄膜の微細加工技術を金属・半導体分離した SWCNT に拡張し、機能性薄膜の作製および高性能デバイス化を進める。加えて、有機分子溶液滴下による、結晶性薄膜作製を試みる。

(2)デバイス自体の高性能化技術確立

これまでに確立したドーピング技術を用いてインバーター作製に着手する。

加えて、共振器構造を導入した単結晶発光トランジスタへ高電流密度実現技術および低温実験を組み合わせ、電流励起による Amplified Spontaneous Emission に挑戦する。

(3) 両者を組み合わせた高性能実デバイスの全構成要素の IJ 法作製

気相成長単結晶とIJ 法で作製した SWCNT 配線の組み合わせでトランジスタを作製する。

2. 研究の実施状況

(1)IJ 法に関する基盤技術確立

本研究項目では、前年度までに確立した SWCNT 微細加工技術を基にする予定であったが、インクジェット 法を用いた SWCNT 構造体作製技術とは異なり親水・疎水界面を用いた新しい方法を確立する事に成功した。本手法では、より大きな構造体の作製が可能となり、本質的な伝導特性の評価などを行う事に成功している。デバイス作製にも成功しており、高い易動度(>10cm²/Vs)の観測にも成功している。一方、有機 材料を用いた結晶成長に関しては、他グループから多くの手法が報告されており、それらを採用する。

(2)デバイス自体の高性能化技術確立

本研究項目では、これまでにポリイミドを用いたドーピング技術を確立していたが、さらに発展させてポリイミドとイオンゲルを組み合わせたトランジスタ作製およびインバーター作製に成功した。これにより、sub-threshold の大幅な改善に成功し、これまで1を大きく下回っていたゲインを 8 まで引き上げる事に成功した。これは、インバーターの連結による増幅が可能である事を意味しており、リングオシレーターへの道筋を示すことが出来た。また、有機単結晶では回折格子を導入したトランジスタは表面への欠陥導入の為、大幅に発光特性が劣化する問題が生じた。しかしながら、加工プロセスの最適化により、最終的には、共振器構造を導入した単結晶発光トランジスタ実現に成功した。同時に、高電流密度実現技術および

様式19 別紙1

低温実験との組み合わせを進めており、引き続き電流励起による Amplified Spontaneous Emission に挑戦する。

(3) 両者を組み合わせた高性能実デバイスの全構成要素の IJ 法作製

気相成長単結晶とIJ法で作製したSWCNT配線の組み合わせでのトランジスタ試作を行った。一応の素子駆動は確認されたが、残念ながら特性には問題が見受けられた。これは、印刷による基板表面の汚染が、結晶に影響を与えるためである。一方で、有機半導体トランジスタに比べ十分優れたSWCNTトランジスタ作製技術確立に成功した為、これらを組み合わせたトランジスタ印刷法のみを用いた回路作製に成功した。他技術の組み合わせによる、IJ法を用いたリングオシレーターなどの大規模論理回路素子作製の基盤が確立されたと言える。

3. 研究発表等

雑誌論文 (掲載済みー査読有り) 計 10 件

計 10 件

1. Ambipolar organic single-crystal transistors based on ion-gels

Advanced Materials, 24(32), 4392-4397,2012/8/22

Yohei Yomogida, Jiang Pu, Hidekazu Shimotani, Shimpei. Ono, Shu Hotta,Yoshihiro Iwasa, <u>Taishi</u> <u>Takenobu</u>

2. Optically pumped amplified spontaneous emission in an ionic liquid-based polymer light-emitting electrochemical cell

Tomo Sakanoue, Kosuke Sawabe, Yohei Yomogida, <u>Taishi Takenobu</u>, Shiro Seki, and Shimpei Ono, Applied Physics Letters, 100(26), 263301, 2012/6/25

- 3. Fine Patterning of Inkjet-Printed Single-Walled Carbon-Nanotube Thin-Film Transistors Yuki Nobusa, Yuki Takagi, Shota Gocho, Satoki Matsuzaki, Kazuhiro Yanagi, and <u>Taishi Takenobu</u> Japanese Journal of Applied Physics,51(6), 06FD15,2012/6/20
- 4. Continuous Electron Doping of Single-Walled Carbon Nanotube Films Using Inkjet Technique Satoki Matsuzaki, Yuki Nobusa, Ryo Shimizu, Kazuhiro Yanagi, Hiromichi Kataura, and <u>Taishi Takenobu</u> Japanese Journal of Applied Physics,51,06FD18,2012/6/20
- Highly Flexible MoS2 Thin-Film Transistors with Ion Gel Dielectrics
 Jiang Pu, Yohei Yomogida, Keng-Ku Liu, Lain-Jong Li, Yoshihiro Iwasa, and <u>Taishi Takenobu</u>
 NANO Letters, 12(8),4013-4017,2012/7/16
- Realization of ohmic-like contact between ferromagnet and rubrene single crystal Yuta Kitamura, Eiji Shikoh, Kosuke Sawabe, <u>Taishi Takenobu</u>, and Masashi Shiraishi Applied Physics letters,101(7),73501,2012/8/13
- Current-Confi nement Structure and Extremely High Current Density in Organic Light-Emitting Transistors

Kosuke Sawabe , Masaki Imakawa , Masaki Nakano , Takeshi Yamao , Shu Hotta ,Yoshihiro Iwasa , and Taishi Takenobu

Advanced Materials, 24(46),6141-6146,2012/12/4

8. Optical Signature of Charge Transfer in n-Type Carbon Nanotube Transistors Doped with Printable Organic Molecules

Ryo Shimizu, Satoki Matsuzaki, Kazuhiro Yanagi, <u>Taishi Takenobu</u>

Applied Physics express,5(12),125102,2012/11/21

- Organic Single-Crystal Light-Emitting Transistor Coupling with Optical Feedback Resonators
 Satria Zulkarnaen Bisri, Kosuke Sawabe, Masaki Imakawa, Kenichi Maruyama, Takeshi Yamao, Shu Hotta,
 Yoshihiro Iwasa & Taishi Takenobu
 - Scientific Reports, 2,985, 2012/12/17
- 10. Electron spin resonance observation of charge carrier concentration in organic field-effect transistors during device operation

Hisaaki Tanaka, Masataka Hirate, Shun-ichiro Watanabe, Kazuaki Kaneko, Kazuhiro Marumoto, <u>Taishi</u> <u>Takenobu</u>, Yoshihiro Iwasa, and Shin-ichi Kuroda

PHYSICAL REVIEW B,87(4),45309,2013/1/18

様式19 別	式19 別紙1								
	11. Electron Spin Resonance Study of Organic Interfaces in Ion Gel-Gated Rubrene Single-Crystal Transistors Yuki Takahashi, Masaki Tsuji, Yohei Yomogida, <u>Taishi Takenobu</u> , Yoshihiro Iwasa, and Kazuhiro Marumoto Applied Physics Express, 6, 41603, 2013								
	(掲載済みー査読無し) 計 0 件								
	(未掲載) 計 0 件								
会議発表	専門家向け 計 48 件								
計 48 件	 Masaki Imakawa, <u>Taishi Takenobu</u>, et al., Extremely High Current Density in Ambipol Organic Single-Crystal Light-emitting Transistor, USA, 2012/4/11, 2012 MRS Spri Meeting & Exhibit 								
	2. Hidekazu Shimotani, <u>Taishi Takenobu</u> , et al., One-dimensional Nature in Transport								
	Property of SWNT Thin Film Electrochemical Transistor, USA, 2012/4/11, 2012 MRS								
	Spring Meeting & Exhibit								
	3. Taishi Takenobu(Invited), Inkjet-printing of Single-walled Carbon-nanotube Thin-film								
	Transistors, USA, 2012/4/12, 2012 MRS Spring Meeting & Exhibit								
	4. Yohei Yomogida, <u>Taishi Takenobu</u> , et al., Light-emitting Organic Single-crystal								
	Transistors Using Ion-gel, USA, 2012/4/12, 2012 MRS Spring Meeting & Exhibit								
	5. Satoki Matsizaki, <u>Taishi Takenobu</u> , et al., Single-walled Carbon Nanotube Thin Film								
	Transistor Using Ink-jet Technique to Pattern Metallic, Semiconducting, and Insulating								
	Inks, USA, 2012/4/12, 2012 MRS Spring Meeting & Exhibit								
	6. <u>竹延大志(</u> 招待講演)、有機レーザートランジスタ、茨城、2012/5/25、第 3 回つくばグリー ンイノベーションフォーラム								
	7. <u>Taishi Takenobu (Invited)</u> , Organic Single-crystal Light-emitting								
	Transistors, China, 2012/6/8, Advanced Materials 2012								
	8. <u>Taishi Takenobu</u> , Yohei Yomogida, et al., Inkjet Printing of High-Performance and Ultra-Flexible Single-Walled Carbon-Nanotube Transistors, Australia, 2012/6/27, NT12								
	9. <u>Taishi Takenobu</u> , Jiang Pu, et al., Highly Flexible MoS2 Thin-Layers Transistor with Ion								
	Gel Dielectrics, Australia,2012/6/28,NT12 10. Shota Gotyo, <u>Taishi Takenobu</u> , et al., Exciton confinement structure in organic light-emitting transistors,東京,2012/9/7,ICFPE2012								
	11. Kenichi Maruyama, <u>Taishi Takenobu</u> , et al., Light-emitting organic crystal transistors with distributed feedback structures,東京,2012/9/7,ICFPE2012								
	12. <u>Taishi Takenobu(Invited)</u> , Ion -gel transistors for gel transistors for flexible,								
	stretchable ,and high -performance applications,東京,2012/9/10,EDLT TOKYO 13. 今川雅貴, <u>竹延大志</u> 他, コオリゴマー材料のトランジスタ特性,愛媛,2012/9/12,秋季 第 73 回応用物理学会								
	14. 高橋優貴, <u>竹延大志</u> 他, イオンゲルを用いたルブレン単結晶電気ニ重層トランジスタの 電子スピン共鳴によるミクロ評価, 愛媛,2012/9/12,秋季 第 73 回応用物理学会								
	15. 松本大佑, <u>竹延大志</u> 他, イオンゲルを用いた半導体カーボンナノチューブ薄膜電気二重層トランジスタの電子スピン共鳴によるミクロ評価, 愛媛,2012/9/12,秋季 第 73 回応用物								
	理学会								
	16. 丸山建一, 竹延大志 他, ナノインプリント法による有機単結晶の微細加工, 愛媛,2012/9/13,秋季 第 73 回応用物理学会								
	17. 船迫友之, 竹延大志 他, 全固体型単層カーボンナノチューブエレクトロクロミック素子の								
	開発, 愛媛,2012/9/12,秋季 第 73 回応用物理学会 18. 松崎怜樹, <u>竹延大志</u> 他, インクジェット法を用いた完全塗布型オールカーボンフレキシブ								
	18. 松崎怜樹, <u>竹延入志</u> 他, インクシェット法を用いた元宝塗布型オールカーボンフレキシフルトランジスタ, 愛媛,2012/9/13,秋季 第 73 回応用物理学会								
	19. 工藤 光, 竹延大志 他, 単一(6,5)カイラリティ単層カーボンナノチューブ厚膜におけるイオ								
	ンゲルトランジスタ,愛媛,2012/9/13,秋季 第 73 回応用物理学会								

- 20. 野房勇希, <u>竹延大志</u> 他, 単層カーボンナノチューブトランジスタの圧縮・引張特性, 愛媛, 2012/9/13, 秋季 第 73 回応用物理学会
- 21. 清水 諒, <u>竹延大志</u> 他,単層カーボンナノチューブ膜への連続的電子ドーピング, 愛媛,2012/9/13,秋季 第 73 回応用物理学会
- 22. 蒲 江, <u>竹延大志</u> 他,フレキシブル MoS₂ 薄膜トランジスタ, 愛媛,2012/9/13,秋季 第 73 回 応用物理学会
- 23. 丸本一弘, 竹延大志 他, 電気二重層トランジスタにおける高密度電荷の2次元磁気相互作用と磁性, 神奈川, 2012/9/19, 日本物理学会2012年秋季
- 24. 蒲江, <u>竹延大志</u> 他, イオンゲルを用いた MoS2 薄膜トランジスタ,神奈川,2012/9/19,日本 物理学会 2012 年秋季
- 25. <u>竹延大志</u>, インクジェット法を用いたナノチューブエレクトロニクス,東京,2012/9/26, JOEM アカデミー 2012
- 26. <u>Taishi Takenobu(Invited)</u>, Organic Single-crystal Light-emitting Transistors with built-in structure, USA, 2012/10/28,0EFT 2012
- 27. Satoki Matsuzaki, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Fully Inkjet-Printed All Carbon Flexible Transistor, Miyagi, 2012/10/29, A3 Symposium of Emerging Materials: Nanomaterials for Energy and Environments
- 28. Yuki Nobusa, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Bending Properties of Single-Walled Carbon Nanotube Film Transistors,2012/10/29,A3 Symposium of Emerging Materials:Nanomaterials for Energy and Environments
- 29. R.Shimizu, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Multiple Investigation of ChargeTransfer between Single-walled Carbon Nanotubes and N-type Dopants, Hyogo,2012/10/31, MNC2012
- 30. Y.Takagi, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Inkjet Printing of Aligned Carbon-nanotube Thin Films, Hyogo, 2012/11/1, MNC2012
- 31. <u>Taishi Takenobu</u>, Ambipolar functionalities of organic single-crystal transistors, USA, 2012/11/27,MRS Fall Meeting&Exhibit
- 32. <u>竹延大志(</u>招待講演), カーボンナノチューブプリンテッドエレクトロニクスにおける濡れ拡が り対策,東京,2013/2/20, 技術情報協会
- 33. <u>竹延大志(</u>招待講演), 有機単結晶を用いた発光素子,東京 2013/2/21, 電気学会 第 6 回パワー半導体光源とその応用技術調査専門委員会
- 34. Yoshifumi Wada, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Electric double layer transistors of aligned carbon nanotube thin film,Tokyo,2013/3/1,ITC2013
- 35. Hiroki Hamahata, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Bending Properties of Single-Walled Carbon Nanotube Film Transistors, Tokyo, 2013/3/1, ITC 2013
- 36. Yuki Takagi, $\underline{\text{Taishi Takenobu}}$ et al., Inkjet printing of aligned carbon-nanotube thin films, $\underline{\text{Tokyo}}$, $\underline{\text{2013}}$ /1, $\underline{\text{ITC2013}}$
- 37. Ryo Shimizu, <u>Taishi Takenobu</u> et al., カーボンナノチューブ電気二重層トランジスタにおける p-n 接合の形成,東京, 2013/3/11, 第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 38. 高木勇樹, <u>竹延大志</u> 他, 液相法によるカーボンナノチューブワイヤー, 東京, 2013/3/11, 第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 39. 河合英輝,<u>竹延大志</u> 他, String-like Aggregates of Aligned (6, 5) Single Wall Carbon Nanotubes, 東京, 2013/3/11, 第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 40. Hiroki Hamahata, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Bending Properties of Single-Walled Carbon Nanotube Film Transistors, 東京, 2013/3/12, 第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 41. 工藤光,<u>竹延大志</u> 他, Electric Double Layer Transistors using Thick Films in Single Chiral States of (6,5) and (11,10) Single-Wall Carbon Nanotubes,東京, 2013/3/12,第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 42. Yoshifumi Wada, <u>Taishi Takenobu</u> et al., Electric double layer transistors of aligned carbon nanotube thin film, 東京, 2013/3/13, 第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 43. <u>Taishi Takenobu(招待講演)</u>, 新しい機能性ナノチューブトランジスタ,東京,2013/3/13, 第 44 回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム
- 44. 和田義史, <u>竹延大志</u> 他, 電気二重層トランジスタにおけるイオン液体の周波数特性,広島,2013/3/26,日本物理学会 第 68 回年次大会

様式19 別紙1

様式19 別利	χ I
	45. 蒲江, <u>竹延大志</u> 他, MoS2 電気二重層トランジスタにおける一軸性歪みの影響, 広島,2013/3/26,日本物理学会 第 68 回年次大会
	場,2013/3/20,日本物理子会 第 00 日午久入会 46. 牛膓翔太, <u>竹延大志</u> 他, 位置選択的界面発光層を有する有機単結晶発光トランジスタ,
	広島,2013/3/27,日本物理学会 第 68 回年次大会
	47. 丸山建一, <u>竹延大志</u> 他,有機フォトニック単結晶を用いた両極性発光トランジスタの作製,
	広島,2013/3/27,日本物理学会 第 68 回年次大会
	48. 丸本一弘. <u>竹延大志</u> 他, イオンゲルを用いた電気二重層トランジスタの ESR 研究, 広島,2013/3/27,日本物理学会 第 68 回年次大会
図書	
計 0 件	
	(取得済み)計0件
出願•取得状	
況	(出願中) 計0件
計0件	
高F ∪ 1 1+	
Webページ	http://www.f.waseda.jp/takenobu/first.html
(URL)	
国民との科	○近隣の一般住民の方々に研究室を公開し研究の詳細を実際の測定装置を見せながら説明、2012 年 8 月
学·技術対話 の実施状況	 4-5 日(オープンキャンパス)、早稲田大学 西早稲田キャンパス、一般、150 名程度、インクジェット法を用
	いた SWCNT トランジスタや発光する有機トランジスタに関して
	〇近隣の一般住民の方々に研究室を公開し研究の詳細を実際の測定装置を見せながら説明、2012 年 11 月
	3-4 日、早稲田大学 西早稲田キャンパス、一般、60 名程度、インクジェット法を用いた SWCNT トランジス
	タや発光する有機トランジスタに関して
新聞·一般雑	1. 蒲江, <u>竹延大志</u> 他, Molybdenum Disulfide Enables Flexible Transistors,2012/7/26, Chemical &
誌等掲載 計2件	Engineering News, ISSN: 0009-2347
	2. 竹延大志.ナノカーボンが未来を創る(上) ナノカーボン材で新たな価値の創造,2013/2/6,半導体産業新
	聞,第 2026 号
その他	

4. その他特記事項

課題番号 GR088

実施状況報告書(平成24年度) 助成金の執行状況

本様式の内容は一般に公表されます

1. 助成金の受領状況(累計)

(単位:円)

が火型の支債がが、未前が一つには、一つには、一つには、一つには、一つには、一つには、一つには、一つには、							
	①交付決定額		③当該年度受 領額	(4)(=(1)-(2)- (3) 丰盛領領	既返還額(前 年度迄の累 計)		
直接経費	126,000,000	56,000,000	35,000,000	35,000,000	0		
間接経費	37,800,000	16,800,000	10,500,000	10,500,000	0		
合計	163,800,000	72,800,000	45,500,000	45,500,000	0		

2. 当該年度の収支状況

(単位:円)

						\ + + 	
	①前年度未執 行額		③当該年度受 取利息等額 (未収利息を除 く)		⑤当該年度執 行額		当該年度返還 額
直接経費	90,764	35,000,000	0	35,090,764	35,009,225	81,539	0
間接経費	40,492	10,500,000	0	10,540,492	10,518,764	21,728	0
合計	131,256	45,500,000	0	45,631,256	45,527,989	103,267	0

3. 当該年度の執行額内訳

(単位:円)

		金額	備考
	物品費	23,310,726	機械装置6件、実験試薬、実験器具、他
	旅費	2,574,531	研究調査、学会参加
	謝金・人件費等	6,955,569	人件費:常勤研究員2名、研究補助者2名
	その他	2,168,399	機械器具修繕、学会参加、英文校正、他
直接経費計		35,009,225	
間接経費計		10,518,764	
合計		45,527,989	

4. 当該年度の主な購入物品(1品又は1組若しくは1式の価格が50万円以上のもの)

当該千度の王な牌人物品(「品文は「旭石しては「氏の画情からり)」							
物品名	仕様・型・性能 等	数量	単価 (単位:円)	金額 (単位:円)	納入 年月日	設置研究機関 名	
小型ポンピングス テーション	CF114/NW40	1	819,000	819,000	2012/6/8	早稲田大学	
電流測定チャン バー	東北測器(株)特注仕様	1	683,340	683,340	2012/7/26	早稲田大学	
低温真空プローバ システム	TTP4-B	1	5,820,727	5,820,727	2013/1/24	早稲田大学	
インピーダンスアナ ライザ	IM3570	1	737,100	737,100	2013/2/25	早稲田大学	
顕微鏡用真空冷却 加熱ステージ	10086L	1	4,482,135	4,482,135	2013/3/7	早稲田大学	
電子ビーム蒸着ユニット	SVC-EB	1	3,307,500	3,307,500	2013/3/15	早稲田大学	